







	<h2 style="color: red;">SIHD3N50D-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHD3N50D-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p> <p>Datenblätter:  SIHD3N50D-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHD3N50D-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 3A (Tc) 69W (Tc) Surface Mount TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	69W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 Ohm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	175pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHD3N50D-GE3CT

SIHD3N50D-GE3 ist neu im Original, Suche SIHD3N50D-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHD3N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHD3N50D-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHD3N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p>	 <p>SIHD5N50D-GE3 Vishay / Spectrol MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p>SIHD5N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p>SIHD2N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.8A DPAK</p>
 <p>SIHD14N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 600V 13A DPAK</p>	 <p>SIHD3N50D-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p>	 <p>SIHD5N50D-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p>SIHD4N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V FP TO-252</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIHA12N60E	↔ SIHA12N60E-E3	⇒ SIHA12N60E-E3	D SIHA22N60E-E3	↔ SIHA22N60E-E3
↳ SIHA25N50E	⊛ SiHB12N50C	D SIHB12N50C-E3	⇒ SIHB12N50C-E3	↔ SIHB12N50E
⊛ SIHB12N60E	↳ SIHB12N60E-GE3	⊛ SIHB12N60E-GE3	↔ SiHB12N65E	↔ SIHB15N50E
D SIHB15N60E-GE3	⊛ SIHB15N60E-GE3	↳ SiHB15N65E	⊛ SiHB16N50C	↔ SIHB16N50CTR-E3
⇒ SIHB18N60E	↔ SIHB33N60E-GE3	⊛ SIHB33N60E-GE3	↳ SIHD3N50D-GE3	↔ SIHD7N60E-GE3
↔ SIHD7N60E-GE3	⇒ SIHF10N40D	D SIHF10N40D-E3	⊛ SIHF10N40D-E3	↳ SIHF12N50C
⊛ SIHF12N50C-E3	D SIHF12N50C-E3	⇒ SIHF12N60E	↔ SIHF12N60E-E3	↔ SIHF12N60E-E3
↳ SIHF12N60E-GE3	⊛ SIHF12N60E-GE3	↔ SIHF12N60E-GE3	⇒ SIHF12N65E	↔ SIHF15N60E
⊛ SIHF15N60E-E3	↳ SIHF15N60E-E3	⊛ SIHF15N60E-EG3	D SIHF15N60E-GE3	↔ SIHF15N60E-GE3
↔ SIHF16N50C	⊛ SIHF16N50C-E3	↳ SIHF16N50C-E3	⊛ SIHF18N50C-E3	↔ SIHF18N50C-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited